

(19) 世界知的所有權機關  
國際事務局



(43) 國際公開日  
2005年2月3日 (03.02.2005)

PCT

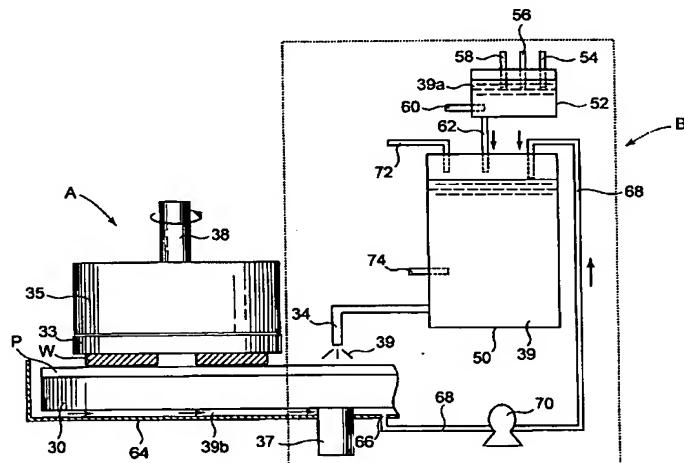
(10) 国際公開番号  
**WO 2005/010966 A1**

(51) 国際特許分類:	H01L 21/304, B24B 37/00	西郷村大字小田倉字大平 150 信越半導体株式会社 半導体白河研究所内 Fukushima (JP).
(21) 国際出願番号:	PCT/JP2004/009731	(74) 代理人: 石原 詔二 (ISHIHARA, Shoji); 〒1700013 東 京都豊島区東池袋 3 丁目 7 番 8 号 若井ビル 302 号 石原國際特許事務所内 Tokyo (JP).
(22) 国際出願日:	2004 年 7 月 8 日 (08.07.2004)	
(25) 国際出願の言語:	日本語	(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可 能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(30) 優先権データ: 特願2003-278970	2003 年 7 月 24 日 (24.07.2003)	JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 信越半 導体株式会社 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 2 号 Tokyo (JP).		(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
(72) 発明者; および		
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高松 直之 (TAKA- MATSU, Naoyuki) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡		

〔統葉有〕

**(54) Title: METHOD FOR POLISHING WAFER**

(54) 発明の名称: ウエーハの研磨方法



**(57) Abstract:** A method for polishing a wafer is disclosed which prevents linear defects. In the method for polishing the surface of a wafer, a wafer is held by a rotatable wafer-holding plate and brought into sliding contact with a polishing cloth which is attached to a rotatable polishing plate while supplying a polishing compound to the polishing cloth. As the polishing compound, there is used an alkali solution which mainly contains a generally spherical silica and further contains an organic base or a salt thereof. As the organic base or a salt thereof, there is used a quaternary ammonium hydroxide.

(57) 要約: 線状欠陥が生じないようにしたウエーハの研磨方法を提供する。回転可能なウエーハ保持板にウエーハを保持し、回転可能な定盤に貼付された研磨布に研磨剤を供給するとともに前記ウエーハと研磨布を摺接させてウエーハ表面を研磨する方法において、研磨剤として略球形状のシリカを主成分とし、更に有機塩基又はその塩を含有するアルカリ溶液を用い研磨するようにした。上記有機塩基又はその塩としては第4級アンモニウム水酸化物を用いる。



CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:  
— 國際調査報告書